

### Сведения о ведущей организации

по диссертации Трунькина Игоря Николаевича

“Определение атомной структуры гетеросистем на основе  $A^3B^5$  комплексом методов электронной микроскопии”, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический институт Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФТИАН РАН
Почтовый индекс, адрес организации	117218, Москва, Нахимовский проспект, 34
Веб-сайт	<a href="http://ftian.ru/">http://ftian.ru/</a>
Телефон	Тел.: (499) 129-50-04 Факс: (499) 125-38-26
Адрес электронной почты	<a href="mailto:kvp@ftian.ru">kvp@ftian.ru</a>
Список основных публикаций по теме диссертации (жирным шрифтом выделены авторы с аффилиацией ФТИАН РАН)	<p>1. Лозовский В.Н., <b>Ломов А.А.</b>, Лунин Л.С., Середин Б.М., Чесноков Ю.М. "Кристаллические дефекты в фотопреобразователях, полученных методом термомиграции". Физика и техника полупроводников, 2017, т. 51, № 3, с. 297-301.</p> <p>2. <b>Ломов А.А.</b>, <b>Мяконьких А.В.</b>, Чесноков Ю.М., Шемухин А.А., Орешко А.П. "Комплементарные исследования внутренних пористых слоев кремния, образованных при высокодозной имплантации ионов гелия". Кристаллография, 2017, т. 62, " 2, с. 196-201.</p> <p>3. Адонин А.С., Евграфов А.Ю., Миннебаев В.М., Иващенко Н.Г., <b>Мяконьких А.В.</b>, <b>Рогожин А.Е.</b>, Руденко К.В. "Электромагнитное моделирование, технология и изготовление СВЧ СЗМОШFET переключателей на AlGaIn/GaN гетероструктурах". Микроэлектроника, 2017, т. 46, № 6, с. 424-430.</p> <p>4. <b>Маишев Ю.П.</b>, <b>Шевчук С.Л.</b>, <b>Кудря В.П.</b>, <b>Терентьев Ю.П.</b> "Формирование сверхтонких сплошных пленок металлов методом ионно-лучевой обработки" Труды ФТИАН, 2016, т. 25, с. 124-136.</p> <p>5. <b>Ломов А.А.</b>, <b>Мяконьких А.В.</b>, Орешко А.П., Шемухин А.А. "Исследования процесса аморфизации имплантированных низкоэнергетичными ионами гелия</p>

	<p>приповерхностных слоев кремния". Кристаллография, 2016, т. 61, № 2, с. 195-202.</p> <p>6. <b>Lomov A.A.</b>, Shcherbachev K.D., Chesnokov Y.M., Kiselev D.A., <b>Miakonkikh A.V.</b> "Evolution of structural properties of Si (001) subsurface layer containing He bubbles by low temperature annealing". Proc. SPIE, 2016, Vol. 10224, P. 1022424.</p> <p>7. Khabutdinov R., <b>Semenikhin I.</b>, Davydov F., Svintsov D., <b>Vyurkov V.</b>, Fedichkin L., Borzdov V.M. "Low-dimensional transit-time diodes for terahertz generation". Proc. SPIE, 2016, Vol. 10224, P. 102240M.</p> <p>8. <b>Semenikhin I.</b>, <b>Vyurkov V.</b>, Bugaev A., Khabibullin R., Ponomarev D., Yachmenev A., Ryzhii V. "Sn nanowires in GaAs: experiment and simulation". Proc. SPIE, 2016, Vol. 10114, P. 102240R.</p> <p>9. <b>Miakonkikh A.V.</b>, Tatarintsev A.A., <b>Rogozhin A.E.</b>, <b>Rudenko K.V.</b> "Technology for fabrication of sub-20 nm silicon planar nanowires array". Proc. SPIE, 2016, Vol. 10224, P. 102241V.</p> <p>10. Адонин А.С., Евграфов А.Ю., Миннебаев В.М., Перевезенцев А.В., Черных А.В., <b>Мяконьких А.В.</b>, <b>Рогожин А.Е.</b>, <b>Руденко К.В.</b> "СВЧ ключ с контактами с ёмкостной связью на AlGaN/GaN гетероструктурах". Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы, 2015, № 4, с. 6-14.</p>
--	---

Ведущий научный сотрудник

лаб. Ионно-лучевых технологий ФТИАН РАН,

к.ф.-м.н. В.П. Кудря

